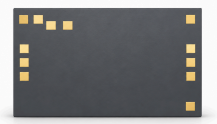
15000–18000 MHz GaN MMIC パワーアンプ・ベアダイ

LCI-PA-15000-18000-PS38T は 15000–18000 MHz をカバーする GaN MMIC パワーアンプのベアダイです。CW およびパルス動作に対応します。

パルス動作: PSAT: 38 dBm (標準値); 電力利得: 20 dB (標準値); PAE: 40 % (標準値).
ダイ寸法: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.



RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; パルス動作

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	15000	-	18000	MHz
飽和出力電力	Psat	-	38	-	dBm
電力利得	Gp	-	20	-	dB
電力利得平坦度	ΔGp	-	-	±0.35	dB
電力付加効率	PAE	-	40	-	%

DC バイアスと電流

TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
ドレイン電圧	Vd	-	28	-	V
ゲート電圧	Vg	-3.2	-3	-2.6	V
ドレイン静止電流	Id	-	0.05	-	A
ドレイン動作電流	Idd	-	0.82	-	A
ゲート動作電流	Igg	-	-	2	mA

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	Vd	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	Vg	-5	-	-	V
最大入力電力	Pin	-	-	23	dBm
保存温度	TSTG	-65	-	150	°C
最大チャネル温度	Top	-	-	200	°C

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	2.3 × 1.35 × 0.08	mm

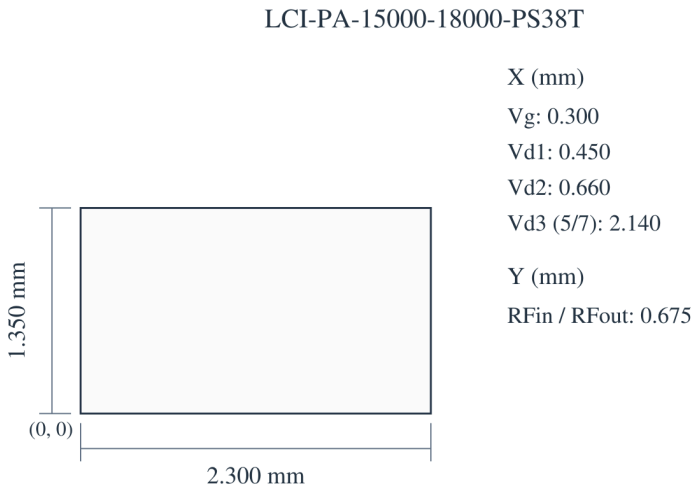
現在の発行記録 · 1.8 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.7.

ダイ実装とバイアスの印加順序

内蔵 DC ブロック: RFin / RFout. 接地への DC 経路: RFin → GND. 別条件での特性評価: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V; Pin = 19 dBm. ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

外形寸法図

外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。



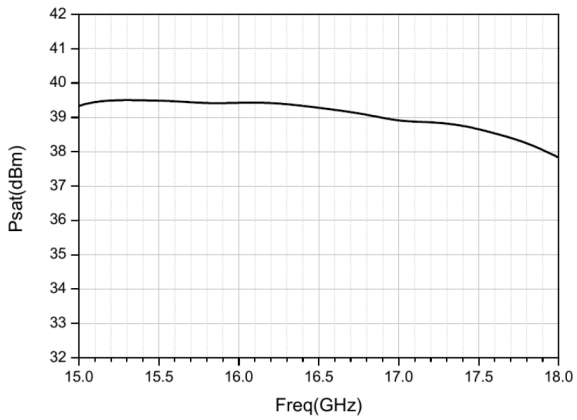
2.300 × 1.350 × 0.080 mm
X, Y: ±0.020 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

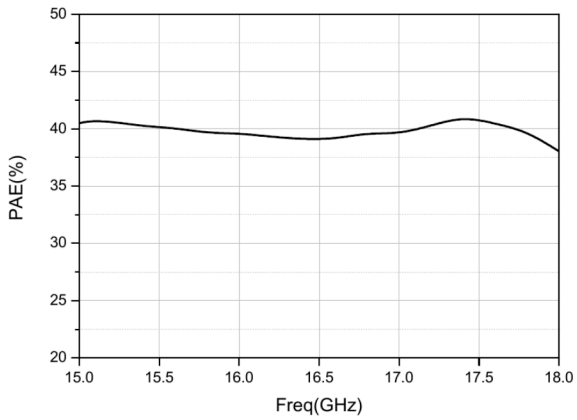
性能特性曲線

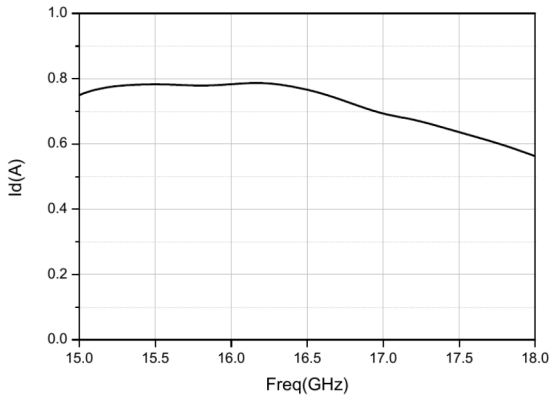
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

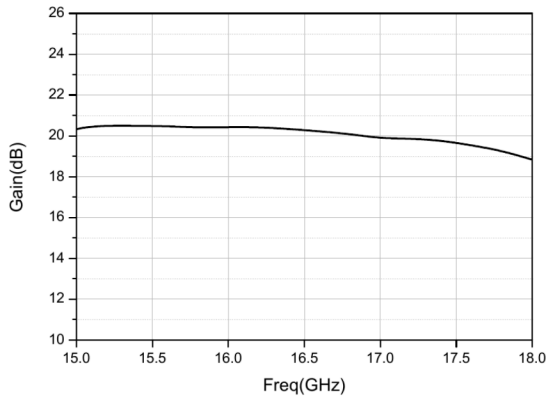
パルスおよびCW特性.

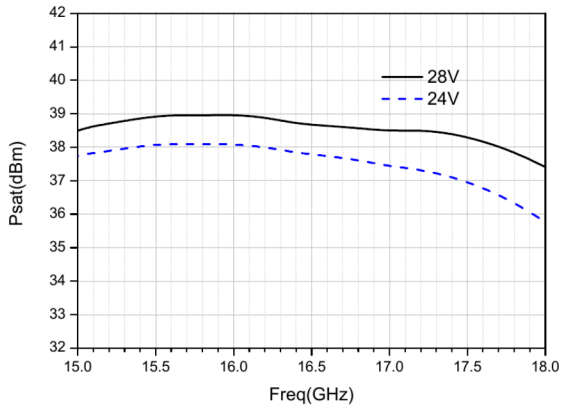
図の注記： (1–4): TA = +25 °C; Vd = 28 V; Vg = −3 V; Pin = 19 dBm. (5–6): CW; Vd = 28 / 24 V. 条件は指定の各図およびその凡例に対応します。

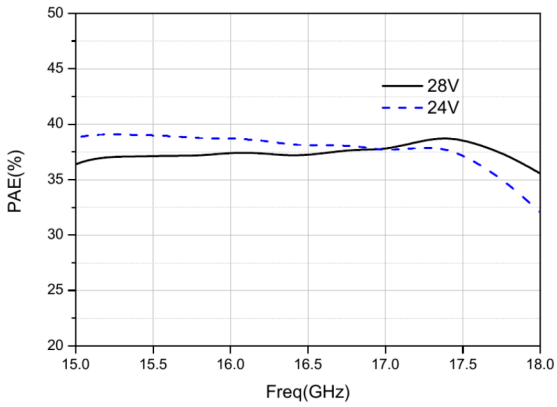












文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。